



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.1

HGC592-3B-W2123

GaAs InGaP HBT MMIC
压控振荡器, 6.5 – 12.5 GHz

3

压控振荡器
|
裸芯片

性能特点

输出功率: +10 dBm

相位噪声: -92 dBc/Hz @ 100 kHz

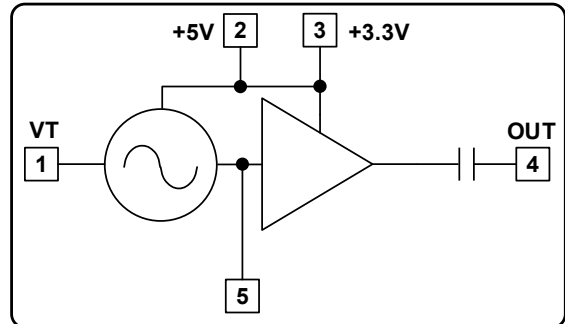
电源供电: +5V/+3.3V @ 60 mA

内部集成缓冲隔离放大器, 射频双路输出

芯片尺寸: $2.1 \times 2 \times 0.1 \text{ mm}^3$

可以提供裸芯片或各种类型封装或 SMA 盒体

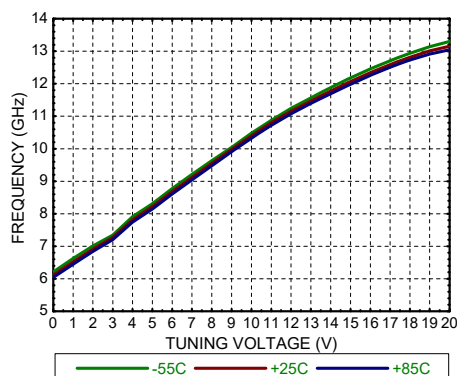
功能框图



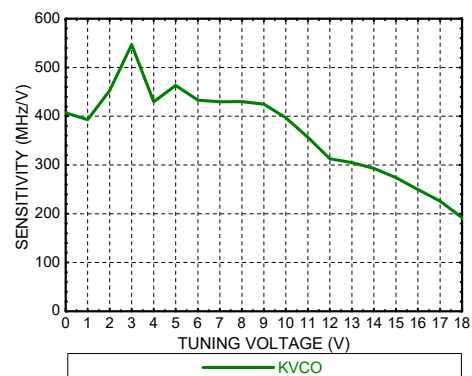
电特性参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5 \text{ V}$, $I_{DD} = 60 \text{ mA}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	6.5 – 12.5			GHz
输出功率 (OUT)		10		dBm
副路输出功率 (OUT2)		1		dBm
SSB 相位噪声@100kHz 频偏处, $V_T = +5\text{V}$ @RF 输出端		-92		dBc/Hz
调谐电压 (V_T)	1		20	V
调谐灵敏度 (KVCO)	200		600	MHz/V
工作电流 (I_{DD}) ($V_{DD} = +5\text{V}$)		60		mA
调谐端口泄漏电流 ($V_T = 13\text{V}$)			10	μA
输出回波损耗		10		dB
二次谐波		-15		dBc

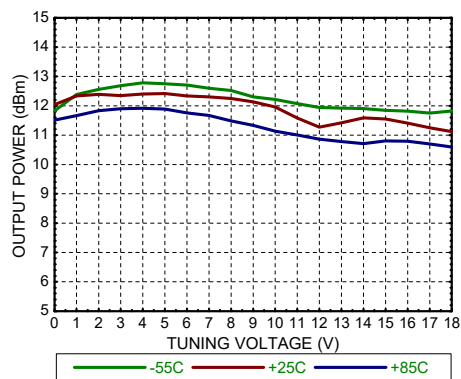
频率 vs. 调谐电压, $T = 25^\circ\text{C}$



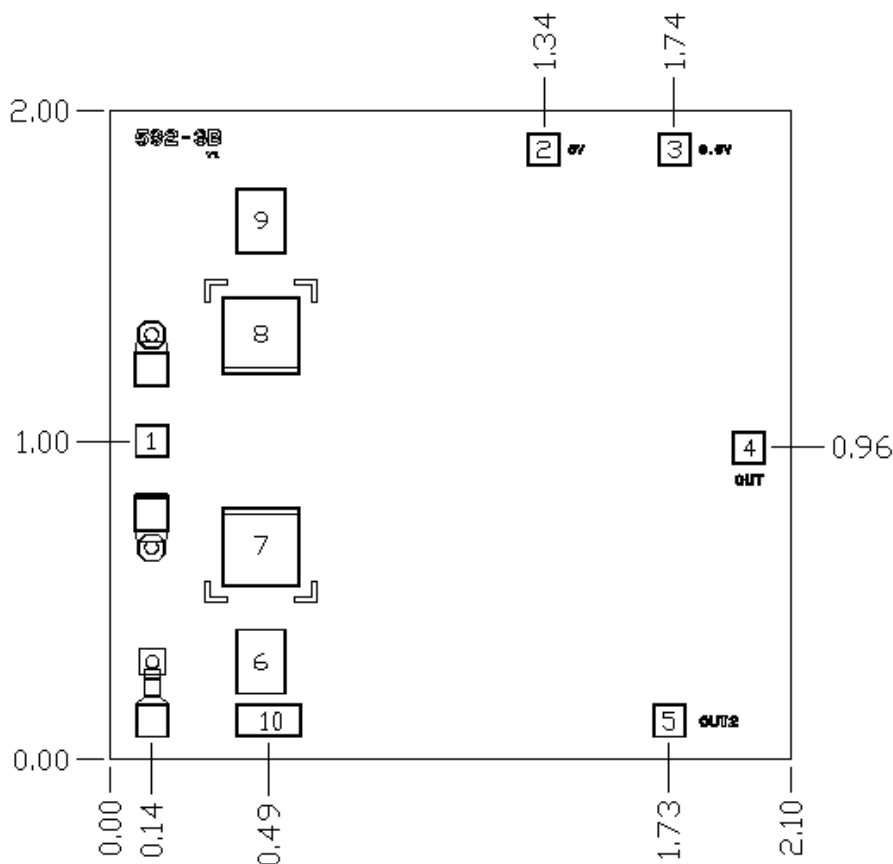
调谐灵敏度 vs. 调谐电压, $T = 25^\circ\text{C}$



输出功率 vs. 调谐电压, $T=25^{\circ}\text{C}$

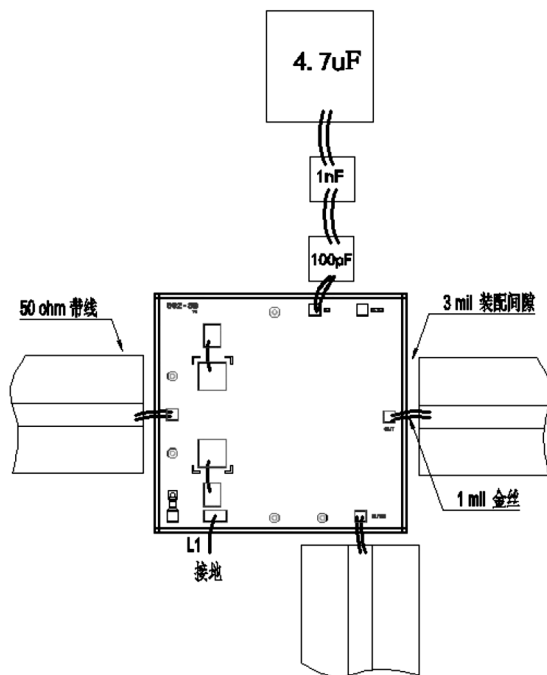


物理参数





装配图



注：该型号压控振荡器所使用的变容二极管型号为中电 55 所 WBX2123H 变容二极管，用户可自行采购或从我司进行采购。

在装配时，需将下路 L1 键合 600~1000um 长的金丝至地。

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	VT	该焊盘提供 VCO 的输入控制电压
2	+5V	该焊盘提供 VCO 的+5V 电源，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容
3	+3.3V	该焊盘提供 VCO 的+3.3V 电源，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 和+3.3V 两种电源仅需选择其中一种，保持电流 60mA
4	OUT	该焊盘是 RF 输出，AC 耦合，并内部匹配至 50 Ohm
5	OUT2	该焊盘是副路 RF 输出，AC 耦合，若不用可连接 50 Ohm
6、9	VAR	该焊盘为变容二极管正极金丝键合处
7、8	VAR	该焊盘为变容二极管负极粘接处
10	BIAS	键合偏置金丝焊盘
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

供电电压：+6 V

储存温度：-65~+150°C

调谐电压：+22 V

工作温度：-55~+85°C